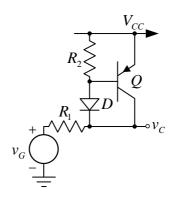
PRVI KOLOKVIJUM IZ OSNOVA ELEKTRONIKE

21.11.2015.

ODSEK ZA FIZIČKU ELEKTRONIKU ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME

1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike su: $\beta_F = 100$, $V_{EB} = V_{\gamma} = V_{EBS} = 0.6 \text{V}$, $V_{ECS} = 0.2 \text{V}$, dioda je idealna sa $V_D = 0.7 \text{V}$, a poznato je i $V_{CC} = 5 \text{V}$, $R_1 = 2 \text{k} \Omega$ i $R_2 = 1 \text{k} \Omega$. Ako se ulazni napon menja u granicama $0 \le v_G \le 5 \text{V}$, odrediti i nacrtati karakteristiku $v_C = f(v_G)$.



Slika 1

- **2.** a) [3] Nacrtati dvostepeni pojačavač sa ulaznim diferencijalnim pojačavačem polarisanim strujnim izvorom, sa ulaznim PNP tranzistorima i izlaznim pojačavačem sa NMOS tranzistorom u spoju sa zajedničkim drejnom.
 - b) [2] Primenom bisekcione teoreme izračunati pojačanje pojačavača iz tačke a).
 - c) [2] Primenom bisekcione teoreme izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
 - d) [2] Primenom bisekcione teoreme izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
 - e) [1] Primenom bisekcione teoreme izračunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti pojačavača iz a).